

LGS5522 数据手册

同步升压型 2 节 2A 锂电池充电管理器

LGS5522

棱晶半导体(南京)有限公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道江淼路 88 号腾飞大厦 C座 14 层



特性

- 最大 2A 的可调充电电流(散热和输入功率限制)
- 支持 7.3V.8.4V 的充满电压(其他电池电压需定制)
- 高达 28V 的输入端耐压
- 高达 28V 的电池端耐压
- 宽输入工作电压范围: 3.0V~6.5V
- 峰值效率可达 93%、重载效率高达 90%
- 外部关断 EN 功能
- 支持最大 110°C温度墙, 充电电流热调节
- 完整的充电状态 LED 指示,单双灯选择
- 超低热阻的 ESSOP10 封装(θ_{JC}=3.9°C/W)
- 可编程的自适应输入限流,自适应适配器负载能力
- 保护: 输入过压、电池过压、电池短路、过温保护、 NTC 电池温度监测
- 支持电池包充电热插拔
- 功率 MOS 全部内置

应用

- 双节锂电池包充电
- 智能门锁

描述

LGS5522 是一款升压型 2 节同步升压充电器,适用于两节串联的锂离子电池。充电电流可通过外部电阻进行设置。

LGS5522 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充电(CV)可确保安全充满电池。支持唤醒深度放电的电池。LGS5522 充满到 8.4V,会关闭充电并持续检测电池电压,下降到 8.2V 自动再充电。当输入电压(USB 源或AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。

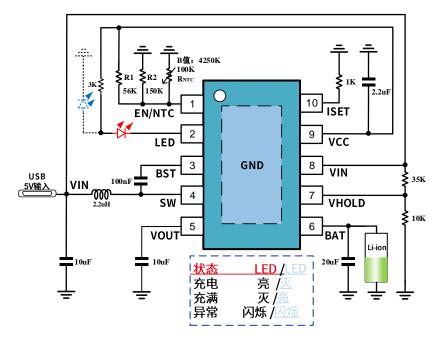
LGS5522 集成充电和充满提示,以及异常指示。

选购指南

Part	Package	Top Mark
LGS5522	ESSOP10	5522 YYWWD

YY:生产年代码. WW:生产周代码.D:固定版本号

典型应用拓扑-5\



5V USB 输入;虚线器件为可选功能(双灯)。

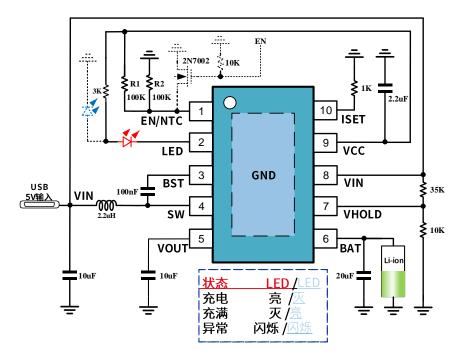


NOTE:

- 升压输出 VOUT 和 BAT 的电容需尽量靠近芯片,并且回路尽量短,此电容优先级最高,可参考 PCB 布局举例。
- NTC 和 EN 引脚为复用,EN 1.1V 为高,0.7V 为低,NTC 使能充电只能在 25%~65%VCC 电压(1.25V~3.25V)。
- NTC 典型应用中需使用 <u>B 值为 4250K 的 100K 阻值</u>的 NTC 电阻与 R2(150K)电阻器并联再与 R1(57.6K)电阻器串联接于 VCC 引脚,这种搭配可保证电池在 0°C~60°C区间正常充电。如使用其他搭配,请参照第 11 页 NTC 功能解释中的给出的各温度阈值区间进行设计或可咨询我司 FAE。
- 底部 ePad GND 引脚,应使用覆铜连接到地平面,有助于最大限度的减小 PCB 传导损耗和热应力,防止因芯片温度过高导致的充电电流下降。
- LED 指示灯使用时需接限流电阻到 VCC,推荐 3K。如需使用双灯方案,必须按照图中 LED 灯颜色配置,请购买对应颜色 LED 灯进行实验,保证两个灯导通电压不在一个电压下,充电时红灯亮,蓝灯灭;充满时蓝灯亮,红灯灭;异常时红灯蓝灯交替闪烁。

元器件选型推荐

符号	含义	推荐值	备注	
C _{VIN}	USB 充电输入稳压电容	10μF, 25V, 0805, 10%	陶瓷电容,耐压值大于 16V	
C _{VCC}	系统供电稳压电容	2.2μF, 16V, 0603, 10%	陶瓷电容,耐压值大于 10V	
C _{VOUT}	升压输出稳压电容	10μF, 25V, 1206, 10%	陶瓷电容,耐压值大于 16V	
C _{BAT}	充电输出稳压电容,电池端	20μF, 25V, 0805, 10%	陶瓷电容,耐压值大于 16V	
C _{BST}	自举电容	100nF, 16V, 0603, 10%	陶瓷电容	
C _{TIM}	充电计时电容	330nF, 6.3V, 0402, 10%	陶瓷电容	
L	功率电感	2.2µH 即可	饱和电流大于 5A,	
R _{ISET}	设置电池恒流充电电流	精度 1%		
D4 D2	たまのも NTO もみぶり	R1=56K,R2=150K 0°C~60°C _o	如果禁用 NTC,R1=R2=100K。	
R1,R2	辅助 NTC 检测	此配置保证 0°C~60°C正常充电。	引脚低于 0.7V,使能关闭。	
R _{NTC}	NTC 热敏电阻	100K,B 值: 4250K 精度 1%	根据设计选择	
D2 D4	设置自适应输入限流的 VIN	将 VHOLD 引脚连接到从 VIN 到 GND 的电阻器网络的中点。	不使用此功能短接工 //// 四司	
R3,R4	电压	当 VHOLD 电压降至 1V 时,充电器会降低充电电流。	不使用此功能短接于 VCC 即可	



5V USB 输入; NTC 禁用,虚线器件为可选功能(双灯和 EN 控制)。



目录

特性	2
描述	2
选购指南	2
典型应用拓扑- 5V	2
元器件选型推荐	3
目录	4
功能框图和引脚描述	5
技术规格	6
功能描述	8
典型应用特征	9
器件推荐	10
NTC 器件选型	11
参考 PCB 布局	12
封装外形描述(ESSOP10)	13
包装信息	14
重要声明和免责声明	15
历史修订记录 ^(t)	15
棱晶半导体(南京)有限公司	www.Legend-Si.com



绝对最大值(†)

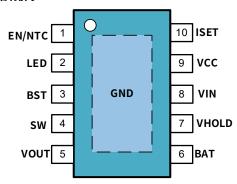
Table 4.1

参数	范围	
引脚至 GND 电压	-0.3V~28V	
(VIN,BAT,VOUT,SW)	-0.30~200	
引脚至 GND 电压	-0.3V~6V	
(ISET,VHOLD ,NTC,VCC)	-0.3v~0v	
引脚到 SW 电压(BST)	-0.3V~6V	
引脚最大电流(SW)	5A	
储存温度	-65°C to 150°C	
工作温度	-40°C to 125°C	
ESD 额定值(HBM)	±2KV	

† 注: 如果器件工作条件超过上述 "绝对最大值",可能引起器件永久性损坏。这仅是极限参数,不建议器件在极限值或超过上述极限值的条件下工作。器件长时间工作在极限条件下可能会影响其可靠性。

引脚排列

图 4. 引脚排列



ESD 警告

ESD(静电放电) 敏感器件。



带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量 ESD时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的 ESD 防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。

功能框图和引脚描述

表 3.2 引脚功能描述

PC C. = 310-1-75	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
引脚编号	引脚名称	描述					
ESSOP10	うりからか	角 边					
1 (1)	EN/NTC	NTC 和 EN 引脚为复用。EN 1.1V 为高,0.7V 为低;NTC 使能充电只能在 25%~65%VCC					
1 (7)	EN/NTC	电压(1.25V~3.25V)。					
2	LED	充电指示。开漏输出,通过限流电阻接 LED 灯至 VDD,充电,灯亮;充满,灯灭。					
3	BST	自举电路引脚。需要在 BST 和 SW 之间连接 100nF 自举电容。					
4	SW	内部功率开关节点。外部连接电感和 Свят 电容。					
5	VOUT	同步升压中间节点。10uF <mark>必须紧靠引脚,否则不正常。</mark>					
6	BAT	接电池正极。将 20uF 陶瓷电容旁路至 GND。					
7 ⁽²⁾	VIIOLD	自适应输入电流限制设置引脚。在 VIN 和 GND 之间连接一个电阻分压网络以配置最小					
/ (2)	VHOLD	输入电压限制阈值。VHOLD 小于 1V,认为适配器限流。					
8	VIN	输入供电和检测 Pin。					
9	VCC	内部电源引脚。至少接 2.2uF 陶瓷电容至 GND。					
		设置恒流充电电流。外部连接 1%精度电阻器到地来设置充电电流。在恒流充电(CC)					
10	ISET	下,此管脚的电压固定在 1V。充电过程的所有模式下,都可以通过测量此管脚的电压来					
		估算充电电流,公式: $I_{BAT}=\left(V_{ICHG}/R_{ICHG}\right)\times 1000$ 。					
EP	EP	GND,系统地。					

- (1) 不使用自适应限流技术,可以将 VHOLD 引脚短接到 VCC。
- (2) NTC 此引脚不支持悬空和接地。(如果禁用 NTC 功能,可以选用两个 100K 电阻从 VIN 分压至 NTC, NTC 会一直处于 50%VCC 阈值)



技术规格

除非另有规定,所有电压均相对于 GND。

表 5.

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源输入						
V_{VIN}	输入电源工作电压		3	5	6.5	V
\/	松入石区铁 草	V _{VIN} 上升沿	2.6	2.8	3.0	V
V_{UVLO}	输入欠压锁定	V _{VIN} 下降沿	2.5	2.6	2.9	V
ΔV_{UVLO}	输入欠压锁定迟滞		50	150	300	mV
V	☆ \ ^+ □ /□ +ò	V _{VIN} 上升沿	6.3	6.6	6.8	V
V _{OVP}	输入过压保护	V _{VIN} 下降沿	5.5	6.3	6.7	V
ΔV_{OVP}	输入过压保护迟滞		200		350	mV
静态电流						
I _{BAT}	电池端漏电	EN=0,VIN=0,BAT=8.4V	18	22	25	μΑ
	输入静态电流	EN=1,BAT 悬空	150	250	350	mA
I_{VIN}	关机电流	EN=0	20	26	30	μΑ
功率管						
$f_{\sf SW}$	Boost 开关频率			750		kHz
充电电压			•			•
V _{CV}	电池充满电压设置	8.4V 版本(默认)	8.35	8.4	8.45	V
ΔV_{RCH}	电池充满后再充电阈值		8.1	8.2	8.3	V
	。	大于此阈值恒流充电	5.3	5.6	5.8	.,
Vcc	恒流充电开启阈值	小于此阈值涓流充电				V
	72.4.4.7.4.7.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	大于此阈值涓流充电,小	1.6	2	2.4	.,
V_{TC}	涓流充电开启阈值	于此阈值短路充电				V
充电电流						
Icc (1)	恒流充电(CC)电流	I _{ISET} =1K	900	1000	1100	mA
I _{TC} (1)	涓流充电(TC)电流	I _{ISET} =1K	90	120	150	mA
Isc (1)	短路充电(SC)电流	I _{ISET} =1K	30	60	90	mA
I _{TERM}	恒压充电(CV)截止充电电流	I _{ISET} =1K	60	120	180	mA
BAT OVP						
V _{OVP}	Output voltage OVP threshold	上升沿		1.2		Vcv
		下降沿		1.1		Vcv
涓流充电 VC	DUT	1				
V_{VOUT}	Bus voltage regulation			6.2		V
V_{TRON}	Blocking FET fully turn on threshold Vtron=Vbat-Vin	V _{BAT} > V _{TC}		100		mV
控制逻辑信号			•			•
V _{ENH}	EN 高电平输入电压	EN Rising		1.4		V
	南京)有限公司		•	V	vww.Legen	d-Si.cor



LGS5522---升压型 2 节锂电池充电管理器

V_{ENL}	EN 低电平输入电压	EN Falling		0.76		
电池温度检测	则NTC					
UTP (2)	欠温保护	Rising edge	62%	65%	68%	VCC
	迟滞		4%	5%	7%	VCC
OTP (2)	过温保护	Falling edge	22%	25%	27%	VCC
	迟滞		2%	2.6%	3%	VCC
Thermal Re	gulation and Thermal shutdown		<u> </u>			•
T _{REG}	热调节阈值			110		°C
OTP	热保护温度	上升阈值		160		°C
OTP _{HYS}	热保护温度迟滞			30		°C

⁽¹⁾ 在充电过程中为了保护电池,芯片会检测电池电压执行四个不同的充电阶段,短路充电(Short Charge)→涓流充电(trickle charge)→恒流充电(Const Current Charge)→恒压充电(Const Voltage Charge)→充电停止。

⁽²⁾ 电池温度控制,芯片会检测 NTC 引脚电压来判断电池的温度。其中使用的 NTC 电阻一般位于电池内部。可根据 NTC 冷热阈值使用其他搭配,请参照 NTC 电压温度阈值的进行设计(第 11 页)。



功能描述

概述

LGS5522 是一款面向 5V 适配器的升压型 2 节锂离子电池升压充电器,宽输入范围 $3.0V\sim6.5V$,最大持续充电电流可达 2A,开关频率 750KHz。

正常充电循环(BAT)

LGS5522 提供四个主要充电阶段: 短路充电、涓流充电、 恒流充电、恒压充电。

短路模式: 当 VBAT 低于涓流充电开启阈值 VTC(2V)时,Boost 工作在轻载,阻塞 FET 工作在线性模式,电池将通过 HS FET 的体二极管充电。充电电流为 I_{CC} 的6%。

涓流充电模式: 当 V_{BAT} 到达 V_{TC} 时,Boost 工作在轻载,调节 VVOUT 为 6.2V,阻断 FET 工作在线性模式。 充电电流为 I_{CC} 的 12%。

恒流充电模式:当 VBAT 高于恒流充电开启阈值 Vcc 时,阻断场效应管完全导通,Boost 工作在恒流模式,充电电流为 Icc。

恒压充电模式: 当 VBAT 接近调节电压时,充电电流开始下降。电流下降到 1/10 lcc 时,关闭充电模式。充电周期就完成了。

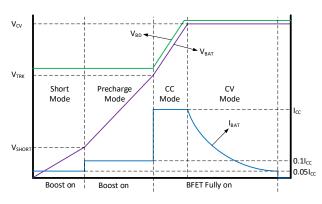


图 7.电池充电循环

自适应输入限流(VHOLD)

自适应输入电流限制设置功能,VHOLD 引脚在 VIN 和 GND 之间连接一个电阻分压网络以配置输入限流时最小 VIN 限制阈值。LGS5522 具有 VIN 输入稳压环路,在检

测到 VHOLD 引脚小于 1V,芯片会自动调整降低充电电流,保证输入电压稳定在设置好输入阈值附近,自适应适配器负载能力。

恒流充电电流设置(ISET)

LGS5522 充电电流可通过连接在 ISET 引脚与地之间的电阻器来设定的。根据需要的充电电流来确定电阻器的阻值。充电过程的所有模式下,都可以通过测量此管脚的电压来估算充电电流。 VISET 电压恒流充电为 1V.

公式: $I_{RAT} = (V_{ICHG}/R_{ICHG}) \times 1000$ 。

R _{ISET}	短路充电	涓流充电	恒流充电	截止电流	
2K	30mA	60mA	500mA	60mA	
1K	60mA	120mA	1000mA	120mA	
0.5K	120mA	240mA	2000mA	240mA	

充电状态指示灯(LED)

LED 引脚接 LED 灯串接限流电阻 RLED 到 VCC 高电平上。

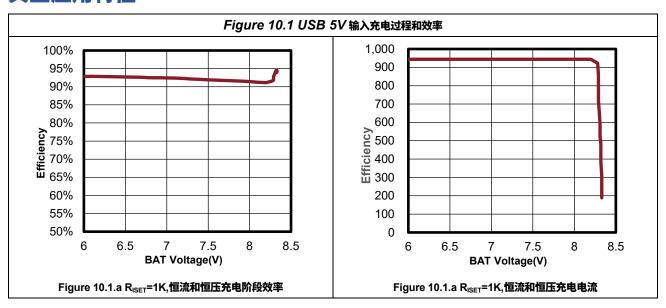
- 1、充电过程中:LED 引脚会拉低电平并保持,LED 长亮;
- 2、充电完成时: LED 引脚会拉高电平并保持, LED 灭;
- 3、故障模式: LED 引脚会以 1Hz 的频率进行高低电平交替输出,LED 闪烁。

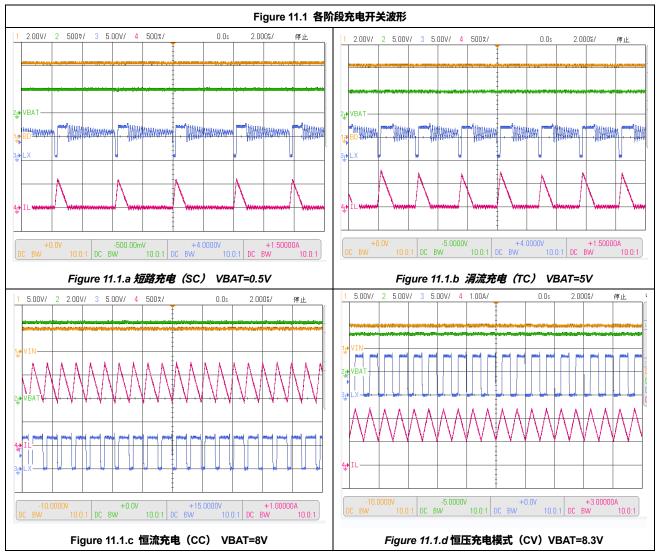
充电状态	LED	单灯
正在充电	Low	亮
充电完成	High	灭
输入限流保护	Blinking at 6Hz	约 6Hz 闪烁
电池温度过热	Blinking at 1Hz	约 1Hz 闪烁
电池温度过冷		
充电超时保护		
输入过压保护		
电池过压保护		
芯片过热保护		

棱晶半导体(南京)有限公司 www.Legend-Si.com



典型应用特征







器件推荐

自举电容 Crst

LGS5522 的 BST 引脚是自举门驱动引脚,提供整流 FET 的栅极驱动器。使用 0.1μ F 陶瓷电容连接到 SW。 C_{BST} 推荐使用 0.1μ F 电容器,耐压值高于 10~16V。

输入电容 Cvin

LGS5522 要求使用去耦电容来滤除输入端的噪声干扰。 去耦电容典型推荐值为 10µF,额定电压必须大于 IC 所 要求的最大输入电压,最好应为最大输入电压的两倍。 该电容的增加可以减小输入电压纹波,并且在负载瞬变 时保持输入端电压的稳定。推荐 10µF 以上的 X5R 或 X7R 陶瓷电容器。

升压输出电容 Cvout

选择输出电容来处理输出纹波噪声要求。纹波电压与电容及其等效串联电阻(ESR)有关。为了获得最佳性能,建议使用 X5R 或更好等级的低 ESR 陶瓷电容器。输出电容的额定电压应高于最大输出电压。

最小所需电容可计算为:

$$C_{OUT} = \frac{I_{CC} \times (V_{OUT} - V_{IN})}{F_{SW} \times V_{OUT} \times V_{RIPPLE}}$$

最 VRIPPLE 是峰峰值的输出纹波,Icc 是设定充电电流 推荐使用大于 10uF 的电容。并且要靠近引脚。

功率电感L

在选择电感时需要考虑几个因素:

选择电感以提供所需的纹波电流。建议选择纹波电流为平均输入电流的40%左右。电感的计算公式为:

$$L = \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}\right)^{2} \frac{(V_{OUT} - V_{IN})}{I_{CC} \times F_{SW} \times 40\%}$$

Fsw 为开关频率; lcc 为设定的 充电电流。 LGS5522 对不同的纹波电流幅值具有相当的容忍度。 因此,最终选择的电感可以在不显著影响性能的情况下 稍微偏离计算值。

电感的饱和电流额定值必须选择大于满载条件下的峰值电感电流。

$$I_{SAT,MIN} > \left(\frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right) \times I_{CC} + \left(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}\right)^2 \frac{(V_{OUT} - V_{IN})}{2 \times F_{SW} \times L}$$

3、电感的 DCR 和开关频率处的磁芯损耗必须足够低, 以达到所需的效率要求。最好选择 DCR<20mΩ的电感, 以实现良好的效率。

BAT 稳压电容 CBAT

选择输出电容来处理输出纹波噪声要求。纹波电压与电容及其等效串联电阻(ESR)有关。为了获得最佳性能,建议使用 X5R 或更好等级的低 ESR 陶瓷电容器。输出电容的额定电压应高于最大输出电压。

最小所需电容可计算为:

$$C_{OUT} = \frac{I_{CC} \times (V_{OUT} - V_{IN})}{F_{SW} \times V_{OUT} \times V_{RIPPLE}}$$

最 VRIPPLE 是输出纹波的峰峰值,Icc 是设定充电电流 推荐使用大于 20uF 的电容。并且要靠近引脚。

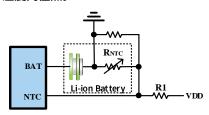


NTC 器件选型

NTC 电阻

为防止温度过高或过低对电池造成的伤害,LGS5522 通过测量 NTC 电压来监测电池温度。当速率 K (K= VNTC/VCC)达到 UTP (Kut)或 OTP (Kot)阈值时,控制器触发 UTP 或 OTP。如果 NTC 管脚的电压小于 VCC 电压的 25%或者大于 VCC 电压的 65%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。温度传感网络如下图所示。

选择 R2 和 R1 来编程合适的 UTP 和 OTP 温度阈值点。



计算步骤:

- 1、定义 Kut, Kut=62%~68%, 典型值 65%
- 2、定义 K_{OT},K_{OT}=22%~27%,典型值 25%
- 3、假设电池 NTC 热敏电阻在 UTP 阈值处为 Rut, 在 OTP 阈值处为 Rot。
- 4、计算 R1

$$R_1 = \frac{R_{OT}R_{UT}(K_{UT} - K_{OT})}{(R_{UT} - R_{OT})K_{UT}K_{OT}}$$

5、计算 R2

$$R_{2} = \frac{R_{OT}R_{UT}(K_{UT} - K_{OT})}{R_{OT}(K_{OT} - K_{OT}K_{UT}) - R_{UT}(K_{UT} - K_{OT}K_{UT})}$$

如果选择典型值 KuT=65%和 KoT=25%,则

$$R_1 = \frac{2.46R_{OT}R_{UT}}{R_{UT} - R_{OT}}$$

$$R_2 = \frac{0.4R_{UT}R_{OT}}{0.0875R_{UT} - 0.4875R_{OT}}$$

我们选择市面上常用的 100K,B 值为 4250K 的 NTC 电阻,计算电池温度在 0° C \sim 60 $^{\circ}$ C下可以充电的 R1,R2 分别为 R1=56K,R2=150K。

温度	R _{NTC}	电阻 B 值	R1	R2	模型
0°C~60°C	10K,精度 1%	3380K	8.2K	36K	0.65 0.55
0°C~60°C	100K,精度 1%	4250K	56K	150K	0.45
-10°C~60°C	10K,精度 1%	3380K	7.87K	22K	0.25 10 20 30 40 50 60 Temp.[degC]
0°C~45°C	10K,精度 1%	3380K	14.3K	820K	0.65
0°C~45°C	100K,精度 1%	4250K	110K	470K	0.45
0°C~45°C	10K,精度 1%	3380K	15K	不需要	0.25 10 15 20 25 30 35 40 45 Temp.[degC]

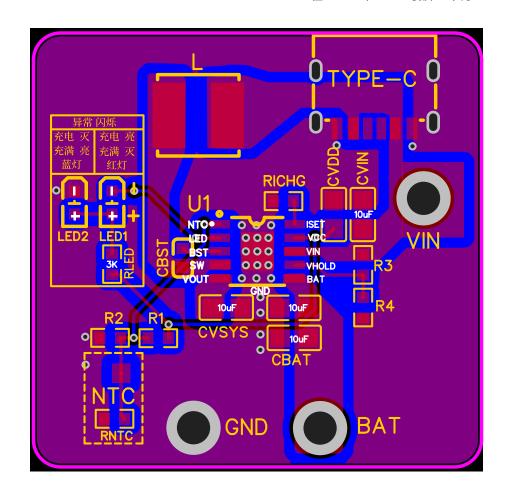


参考 PCB 布局

概述

LGS5522 升压锂离子电池充电器的布局设计相对简单。为了获得最佳的效率和最小的噪声问题,我们应该将以下组件放置在 IC 附近: CVIN、L、CVOUT(CVOUT 电容必须靠近引脚优先级最高)。:

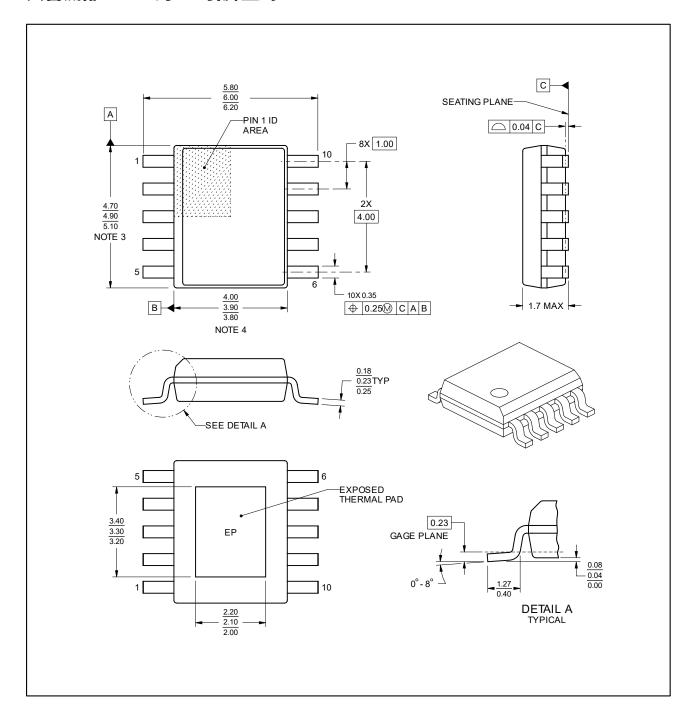
- 功率回路必须尽可能短。
- 輸出回路 C_{VOUT} 电容靠近芯片 VOUT 和 PGND 引脚; CBST 电容是自举电容需要靠近芯片引脚 BST; CBAT 电容尽量靠近芯片引脚 BAT 和 PGND 引脚。
- NTC 要远离 SW 信号减少噪声干扰。
- 对高电流路径应使用较大 PCB 覆铜区域,包括 SW,PGND 引脚和底部散热焊盘。这有助于最 大限度地减少 PCB 传导损耗和热应力。
- 为使过孔传导损耗最小并降低模块热应力,应使用 多个过孔来实现顶层和其他电源层或地层之间的 互连(芯片底部焊盘加过孔开窗有助于芯片散热提 高性能)。
- RNTC 是热敏电阻,用于检测电池的温度,一般位于电池内部,如果在 PCB 板上,建议远离芯片和电感等发热元件。
- VOUT 电容必须靠近芯片足够近,可使用电容放置 在 VOUT 和 GND 引脚上下方





封装外形描述(ESSOP10)

具备底部 ePad 的 10 引脚塑封 SOIC

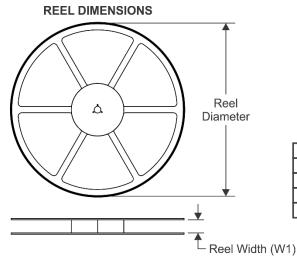


注:

- (1) 所有的数据单位都是亳米,括号内的任何尺寸仅供参考。
- (2) 本图如有更改,恕不另行通知。
- (3) 此尺寸不包括塑模毛边,突起,或水口毛刺。



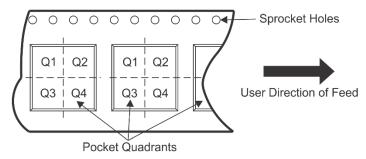
包装信息



TAPE DIMENSIONS + K0 + P1 + B0 W Cavity + A0 + B0 W

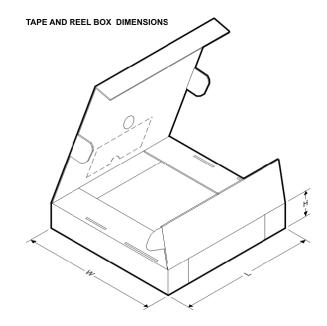
- A0 Dimension designed to accommodate the component width
- B0 Dimension designed to accommodate the component length
- K0 Dimension designed to accommodate the component thickness
- W Overall width of the carrier tape
- P1 Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*ALL dimensions are nominal

	Package	Package			Reel	Reel	4.0	D0	140	D4	147	D: 4
Device	Туре	Drawing	Pins	SPQ	Diameter	Width	A0	B0	K0	P1	W	Pin1
					(mm)	W1(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Quadrant
LGS5522ES	ESSOP10	ES	10	4000	330	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1





重要声明和免责声明

Legend-si 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用 Legend-si 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1) 针对您的应用 选择合适的 Legend-si 产品; (2) 设计、验证并测试您的应用; (3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安 保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。Legend-si 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及 Legend-si 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它 Legend-si 或任何第三方的知识产权授权许可。 如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,Legend-si 对此概不负责,并且您须赔偿由此对 Legend-si 及其代表造成的损害。

Legend-si 所提供产品均受 Legend-si 的销售条款以及 www.Legend-si.com 上或随附 Legend-si 产品提供的其他可适用条款的约束。Legend-si 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 Legend-si 针对 Legend-si 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 江苏省南京市浦口区江淼路 88 号腾飞大厦 C 座 1403 室 电话: 025-58838327

Copyright ©棱晶半导体(南京)有限公司

历史修订记录 (†)

Rev.D V1.0 页码

※ D版。本手册相关参数仅对 D版相关指标描述和承认

ALL

↑NOTE:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。